УДК 621.382

## СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Макаревич А.Л.<sup>1</sup>, Матына Л.И.<sup>2</sup>, Соковнич С.М.<sup>1</sup>

 $^{1}$  Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шеченко, Тирасполь, Приднестровье, mccar-bendery@mail ru

**Аннотация.** Предложены примеры выполнения лабораторных работ по схемотехническому моделированию работы простейших аналоговых устройств - усилителей. Используется программа LTSpice, которая свободно распространяется и широко используется профессионалами и особенно удобна при подготовке студентов по инженерным направлениям.

**Ключевые слова.** Схемотехническое моделирование, параметры усилителей, нелинейные искажения, амплитудно- и фазочастотные характеристики, обучение схемотехнике.

Подготовка специалистов по направлению «Электроника и наноэлектроника» в ПГУ началась еще в середине 90-х гг прошлого века, а по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» — в 2001 г. Причем, подготовка велась на физико-математическом факультете в рамках специальности «Физика», и учебно-методическое руководство осуществлял тогда Физический факультет МГУ. Учебные планы регламентировались образовательными стандартами направления «Физика» с присвоением дополнительной квалификации «Учитель физики», а также стандартами в направлениях упомянутых выше.

Стандарт в направлении «Физика» предусматривает изучение 6 разделов «Общей физики» и 6 разделов «Теоретической физики». При этом перечни дисциплин специализаций был взяты из соответствующих стандартов по подготовке инженеров. Естественно, что достаточно напряженно решался вопрос с общим количеством часов, которое не должно превышать определенного их числа. В дальнейшем, примерно с 2014г., было принято решение о подготовке специалистов с инженерной квалификацией по перечисленным направлениям и уже при двухуровневым образовании, т.е. бакалавров и магистров.

И в первом, и во втором направлении дисциплины, связанные со схемотехникой, имели различные варианты названий, но относились к базовому блоку Б1 в учебных планах [1, 2].

Считаем, что для качественного изучения схемотехники требуется не только учебная литература таких авторов как П. Хоровиц, У. Хилл [3], У. Титце, К. Шенк [4] и И.П. Степаненко [5], а требуется обязательная практика самостоятельного схемотехнического моделирования типовых конфигураций схем усилителей, фильтров и цифровых устройств с созданием собственных рабочих библиотек, и затем уже выполнение экспериментальных лабораторных работ с использованием измерительных приборов и стендов.

Такой подход к изучению схемотехники делает студентов более подготовленными к экспериментальным исследованиям работоспособности электронных устройств.

Для примера приведем 3 лабораторные работы по изучению принципов работы и характеристик усилителей.

Первая работа связана с изучением принципов работы и характеристик усилителя по схеме с ОЭ.

Основные теоретические положения.

Работа выполняется в программе схемотехнического моделирования LTSpice или любой другой «SPICE – совместимой» программе. В процессе работы выполняются следующие виды анализа: выбор рабочей точки (анализ .OP), анализ переходного процесса при усилении синусоидального сигнала (анализ .TRAN), частотный анализ для получения амплитудно-частотной и фаза-частотной характеристик (анализ .AC) и анализ по постоянному току (.DC) для получения передаточных характеристик.

Схема усилителя и назначение ее элементов

Усилитель, собранный по схеме с ОЭ представляет собой однокаскадный усилитель, состоящий из четырех резисторов и транзистора. Схема такого каскада, выполненного на биполярном транзисторе приведена на рисунке 1.

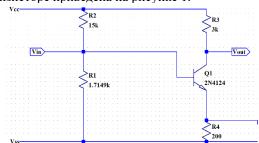


Рисунок 1 – Схема усилителя по схеме с ОЭ

Такой усилитель обычно предназначен для предварительного усиления непрерывных или гармонических синусоидальных сигналов по напряжению.

Основными элементами каскада являются: делитель напряжения на резисторах R1 и R2, нагрузочный резистор R3, резистор R4, стабилизирующий работу биполярного транзистора n-p-n типа (Q1). Входной сигнал Vin подается на базу транзистора, а выходной сигнал Vout определяется падением напряжения на резисторе R3. Эти элементы образуют усилительный каскад. Кроме этого, за счет включения в эмиттерную цепь резистора R4, в схеме возникает отрицательная обратная связь по постоянному и переменному току. Она осуществляет температурную стабилизацию рабочей точки транзистора. Полярность напряжения источника питания Vcc положительна.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> НИУ МИЭТ, г. Москва, Россия

Это обеспечивает для транзистора n-p-n типа смещение коллекторного перехода в обратном, а эмиттерного перехода в прямом направлении, т.е. активный (усилительный) режим работы транзистора Q1.

Для проверки работы усилителя необходимо собрать соответствующую схему, показанную на рисунке 2.2.

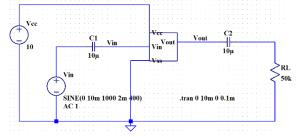


Рисунок 2 – Схема проверки работы усилителя с ОЭ

Здесь конденсаторы С1 и С2 называются разделительными. Они обеспечивают изоляцию (разделение) источника сигнала и нагрузки от каскада по постоянному току и соединение (связь) их по переменной составляющей между собой. Кроме перечисленных элементов принципиальной схемы, при усилении синусоидального сигнала от источника Vin необходим источник постоянного напряжения Vcc вырабатывающий 10 В и нагрузочный резистор RL.

Идеальный усилитель должен увеличивать входной сигнал в заданное число раз без изменения формы сигнала. Причем усилитель с ОЭ инвертирует входной сигнал. При усилении синусоидального сигнала могут возникать искажения, которые бывают двух видов: линейные и нелинейные.

На рисунке 3 показаны осциллограммы входного и выходного сигналов исследуемого усилителя.

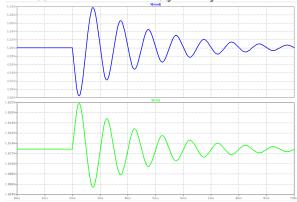


Рисунок 3 — Осциллограммы входного и выходного сигналов усилителя с ОЭ

Приведенный результат моделирования показывает отсутствие нелинейных искажений в усиливаемом сигнале при коэффициенте усиления порядка 10. При увеличении амплитуды входного сигнала до 500мВ можно увидеть появление нелинейных искажений в первом периоде выходного сигнала, приведенного на рисунке 4.

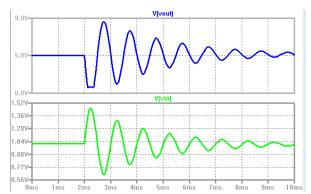


Рисунок 4 – Появление нелинейных искажений в выходном сигнале усилителя

Для снижения эффективности отрицательно обратной связи по току, протекающему через резистор R4 обычно используют конденсатор, включаемый параллельно резистору.

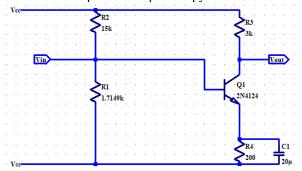


Рисунок 5 – Подключение конденсатора C1 параллельно резистору R4

Подключение конденсатора привело к увеличению коэффициента усиления с 10 до 120 т.е. примерно в 10 раз.

Исследования частотных характеристик усилителя Для получения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик усилителя необходимо провести частотный анализ .AC. Схема, приведенная на рисунке 3.2 позволяет это сделать перейдя от анализа .TRAN к анализу .AC, задав при этом вид шкалы изменения частоты (декадно), число точек на декаду и необходимый диапазон частот.

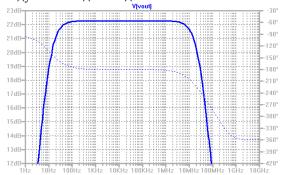


Рисунок 6 – Амплитудно-частотная и фазо-частотная (пунктиром) характеристики

Эти характеристики получены при отсутствии конденсатора С1, подключаемого параллельно резистору R4. При наличии конденсатора коэффициент усиления значительно выше, а частотный диапазон уже (см. рисунок 7).

Рисунок 7 – Амплитудно-частотная и фазо-частотная (пунктиром) характеристики усилителя с конденсатором C1.

Диапазон рабочих частот усилителя по схеме с ОЭ с конденсатором С1 составил от 500  $\Gamma u$  до 15  $M\Gamma u$ .

Полученные результаты частотного анализа подтверждают результаты, полученные при анализе .TRAN.

Для получения передаточных характеристик усилительного каскада, построенного по схеме с ОЭ необходимо провести анализ по постоянному току .DC. Для этого необходимо задать диапазон изменений входного сигнала от источника Vin и исключить из схемы конденсатор C1. И в результате получим статические передаточные характеристики (СПХ) тока и напряжения усилительного каскада.

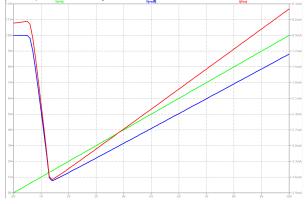


Рисунок 8 – СПХ напряжения и тока усилительного каскада с ОЭ

Вторая работа связана с изучением принципа работы усилительного каскада, собранного на биполярном транзисторе по схеме с общей базой (ОБ) и исследование влияния элементов принципиальной схемы на его частотные и временные характеристики.

Основные теоретические положения

Работа выполняется в программе схемотехнического моделирования LTSpice или любой другой «SPICE – совместимой» программе. В процессе работы выполняются следующие виды анализа: выбор рабочей точки (анализ .OP), анализ переходного процесса при усилении синусоидального сигнала (анализ .TRAN), частотный анализ для получения амплитудно-частотной и фаза-частотной характеристик (анализ .AC) и анализ по постоянному току (.DC) для получения передаточных характеристик.

Схема усилителя и назначение ее элементов

Усилитель, собранный по схеме с ОБ представляет собой однокаскадный усилитель, состоящий из четырех резисторов и транзистора. Схема такого каскада, выполненного на биполярном транзисторе приведена на рисунке 9.

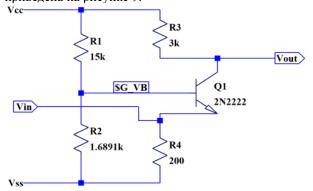


Рисунок 9 – Схема усилителя с ОБ

Такой усилитель обычно используют для усиления непрерывных или гармонических синусоидальных сигналов по напряжению или току в устройствах, работающих на высоких частотах.

Основными элементами каскадаявляются: делитель напряжения на резисторах R1 и R2, нагрузочный резистор R3, резистор R4, стабилизирующий работу биполярного транзистора n-p-n типа (Q1). Эти элементы образуют усилительный каскад. Входной сигнал Vin подается на эмиттер транзистора, а выходной сигнал Vout определяется падением напряжения на резисторе R3. Кроме этого, резистор R4 является нагрузкой для входного сигнала. Полярность напряжения источника питания Vcc положительна. Это обеспечивает для транзистора n-p-n типа смещение коллекторного перехода в обратном, а эмиттерного перехода в прямом направлении, т.е. активный (усилительный) режим работы транзистора Q1.

Для проверки работы усилителя необходимо собрать соответствующую схему, показанную на рисунке 10

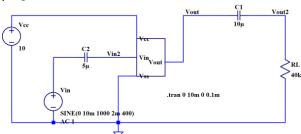


Рисунок 10 – Схема проверки работы усилителя с ОБ

конденсаторы C2C3 Здесь И являются разделительными, T.K. блокируют прохождения постоянного напряжения, задающего рабочий режим транзистора. Они обеспечивают изоляцию (разделение) источника сигнала и нагрузки от каскада по постоянному току и соединение (связь) их по переменной составляющей между собой. перечисленных элементов принципиальной схемы, при усилении синусоидального сигнала от источника Vin необходим источник постоянного напряжения Vcc вырабатывающий 10 В и нагрузочный резистор RL.

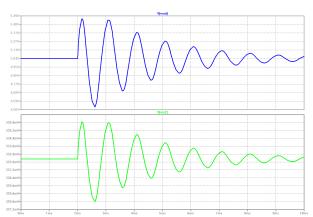


Рисунок 11 – Осциллограммы входного и выходного сигналов усилителя с ОБ

Приведенный на рисунке 11 результат моделирования показывает отсутствие нелинейных искажений в усиливаемом сигнале при коэффициенте усиления порядка 50 и отсутствие инверсии фазы сигнала при его усилении, в отличии от схемы с ОЭ.

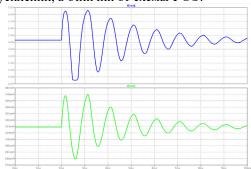


Рисунок 12 — Осциллограммы входного и выходного сигналов усилителя с ОБ

Появление нелинейных искажений в усиливаемом сигнале имело место уже при увеличении амплитуды входного сигнала до 100 мВ.

Исследования частотных характеристик усилителя *ОБ* 

Для получения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик усилителя необходимо провести частотный анализ .AC. Схема, приведенная на рисунке 2 позволяет это сделать перейдя от анализа .TRAN к анализу .AC, задав при этом вид шкалы изменения частоты (декадно), число точек на декаду и необходимый диапазон частот.

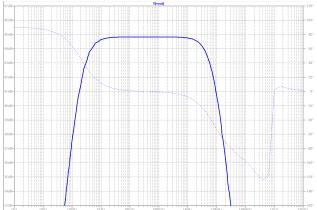


Рисунок 13 — Амплитудно-частотная и фазо-частотная (пунктиром) характеристики усилителя с ОБ

Диапазон рабочих частот усилителя по схеме с ОБ составил от 200 Гц до 9 МГц, что сравнимо с частотным диапазоном усилителя, собранного по схеме с ОЭ при включении конденсатора С1 параллельно резистору R4. При этом коэффициент усиления составлял величину порядка 44 дБ в обоих случаях.

Последняя работа связана с изучением принципов работы и характеристик инвертирующего усилителя на операционном усилителе (OY).

Основные теоретические положения

Эта работа, как и предыдущие, выполняется в программе схемотехнического моделирования LTSpice или любой другой «SPICE – совместимой» программе. В процессе работы выполняются следующие виды анализа: выбор рабочей точки (анализ .OP), анализ переходного процесса при усилении синусоидального сигнала (анализ .TRAN), частотный анализ для получения амплитудно-частотной и фаза-частотной характеристик (анализ .AC) и анализ по постоянному току (.DC) для получения передаточных характеристик.

Номенклатура микросхем ОУ очень большая: от прецизионных, т.е. позволяющих создавать высокоточные преобразователи сигналов до быстродействующих, т.е. применяемых в высокоскоростных преобразователях данных. А каждое применение требует своей схемы включения ОУ. Поэтому в данной работе мы проанализируем простейшую схему усилителя на ОУ. У любого ОУ всегда имеется два входа, т.к. входным каскадом является дифференциальный, который способен усиливать разницу напряжений на входах с очень высоким коэффициентом усиления, значительно превышающим усиление обычного каскада усилителя с ОЭ. При этом, каждое «плечо» дифференциального каскада построено аналогично усилителю с ОЭ, но при этом они взаимодействуют друг с другом, т.к. питаются от одного ограниченного и стабилизированного источника тока. Т.е. при открытии любого из транзисторов, выходное напряжение, определяемое падением напряжения в нагрузочных резисторах будет, как минимум, в 2 раза превышать выходной сигнал обычного каскада с ОЭ. Теоретический анализ работы дифференциального каскада изложен в учебнике И.П. Степаненко «Основы микроэлектроники» [5].

Схема усилителя и назначение ее элементов Схема инвертирующего усилителя на ОУ показана на рисунке 14.

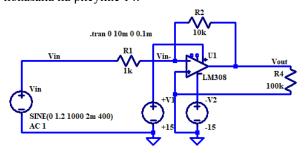


Рисунок 14 — Схема анализа работы инвертирующего усилителя на ОУ

Здесь резисторы R1 и R2 задают коэффициент усиления. Резистор R4 является нагрузкой усилителя. Источники +V1 и -V2 подают питание, необходимое для работы усилителя. Vin – источник входного синусоидального сигнала, с теми же параметрами, что и проверке работы всех предыдущих усилителей: ОЭ, ОБ и ОК. Результаты анализа приведены на следующем рисунке.

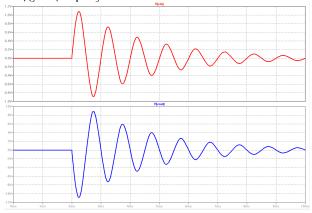


Рисунок 15— Осциллограммы входного (Vin) и выходного (Vout) сигналов инвертирующего усилителя на ОУ

Приведенные примеры выполнения лабораторных работ достаточно просты, но решение таких задач и необходимо на начальном этапе изучения схемотехники при подготовке инженерных кадров в обоих направлениях. Имен такие работы и выполняют наши студенты при изучении дисциплин «Схемотехника телекоммуникационных устройств» [6], «Микросхемотехника» и «Схемотехника».

Изучение усилительных устройств и других схем обработки аналоговых сигналов: фильтров, компараторов и др. обычно предшествует изучению цифровой схемотехники, которую начинаем с изучения простейших логических элементов типа: И, ИЛИ, НЕ. Причем элементы строим как на биполярных, так и обязательно на КМОП транзисторах с проектными нормами в единицы микрон. А затем уже приступаем к изучению работы схем сумматоров, декодеров, кодеров, мультиплексоров и демультиплексоров. После них следуют триггеры и устройства на их основе: регистры и счетчики. При этом каждый обучаемый создает собственную библиотеку аналоговых и цифровых элементов. Но собственная библиотека элементов на КМОП транзисторах может быть использована в дальнейшем при моделировании работы сложных функциональных

узлов, необходимых для построения специализированных микросхем, предназначенных для работы в микроэлектронной аппаратуре самого различного применения: от бытовой техники до систем вооружений.

## Вывод

Считаем, что успешная подготовка инженерных кадров по направлениям «Электроника и наноэлектроника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» возможна при комплексном подходе к изучению дисциплин, связанных со схемотехникой и анализам работоспособности электронных устройств, при котором до начала экспериментальных работ по исследованиям работы электронных схем будет проведено схемотехническое моделирование их работы в любой SPICEсовместимой программе. Тогда полученные результаты позволят проводить экспериментальные работы с большим пониманием их сути. А также это поможет сохранить в рабочем состоянии измерительные приборы и саму электронно-компонентную базу, уберегая их от неизбежных ошибок начинающих экспериментаторов.

## Литература

- 1. Макаревич А.Л. Изучение схемотехники и практические навыки работы в системах проектирования в образовательном процессе в направлениях «Электроника и наноэлектроника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» / Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. №1-2016 стр. 4 9.
- 2. Макаревич А.Л., Матына Л.И., Петренко И.В. Трансформация образовательного процесса подготовки инженерных кадров в условиях смены технологической парадигмы / Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. №4-2020 стр. 25 30.
- 3. Хороваиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2-х т. М.: Мир, 1986.
- 4. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: в 2т. М.: Додэка XXI, 2008.
- 5. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. Учебное пособие для вузов. М.: Сов. радио. 1980 424с.
- 6. Макаревич А.Л., Соковнич С.М., Бочарова В.М. Лабораторный практикум «Схемотехника телекоммуникационных устройств» / Тирасполь, ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 2024 72с.

## CIRCUIT MODELING AND ENGINEERS STAFF TRAINING IN THE DIGITAL ERA

A.L. Makarevich<sup>1</sup>, L.I. Matyna<sup>2</sup>, S.M. Sokovnich<sup>1</sup>

**Abstract.** Examples of laboratory work on circuit engineering modeling of the simplest analog devices - amplifiers are proposed. The LTspice program is used, which is freely distributed and widely used by professionals and is especially convenient for preparing students in engineering fields.

**Keywords.** Circuit modeling, amplifier parameters, nonlinear distortions, amplitude and phase-frequency characteristics, circuit engineering training.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pridnestrovian State University named after T.G. Shevchenko, MD 3300, st. The 25th of October, 128, Tiraspol, Pridnestrovye, mccar-bendery@mail.ru

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> National Research University of Electronic Technology(MIET). Moscow